

	<h2 style="color: red;">SIS454DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIS454DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 35A 1212-8 PPAK
	Datenblätter:  SIS454DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 165 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	





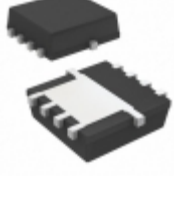
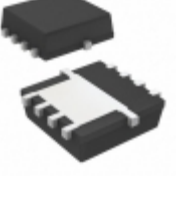

Spezifikationen

Teilenummer	SIS454DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 35A 1212-8 PPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	165 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.7 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SIS454DN-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1900pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 35A (Tc) 3.8W (Ta), 52W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

SIS454DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS454DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS454DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIS454DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIS454DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SIS456DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p>SIS452DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 35A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SIS456DN VB SIS456DN VB</p>
 <p>SIS454DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 35A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SIS452DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 35A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SIS456DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SIS468DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 30A 1212-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIS454DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS454DN-T1-GE3 Datenblatt	SIS454DN-T1-GE3-Datenblätter	SIS454DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIS454DN-T1-GE3
SIS454DN-T1-GE3 Electronic	SIS454DN-T1-GE3-Komponenten	SIS454DN-T1-GE3-Verteiler	SIS454DN-T1-GE3-Bild	SIS454DN-T1-GE3-Teil
SIS454DN-T1-GE3 Preis	SIS454DN-T1-GE3 Hersteller	SIS454DN-T1-GE3 Bild	SIS454DN-T1-GE3 Aktie	SIS454DN-T1-GE3 Inventar
SIS454DN-T1-GE3 Neu	SIS454DN-T1-GE3 Original	SIS454DN-T1-GE3 garantiert	SIS454DN-T1-GE3 RFQ	SIS454DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited